

ブリッジダイオード **低VF・低ノイズタイプ シングルインライン型**  
 Bridge Diode **Low VF・Low Noise type Single In-line Package**

# LL25XB60

**600V 25A**

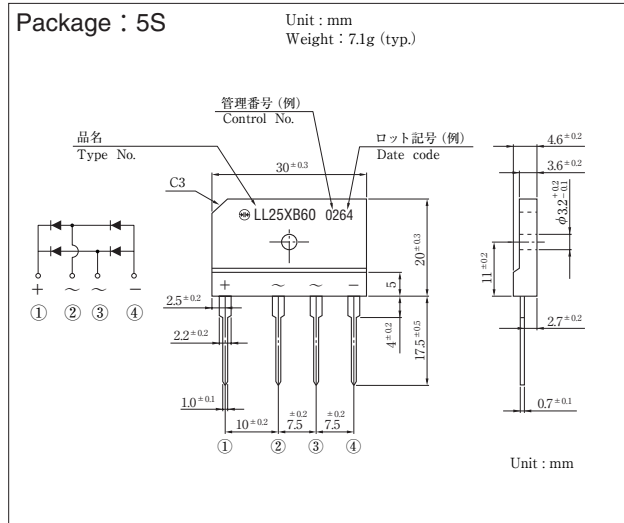
**特長**

- 薄型SIPパッケージ
- 低ノイズ・低VF
- 大電流量
- UL E142422
- 高放熱伝導性

**Feature**

- Thin-SIP
- Low Noise・Low VF
- Large Io
- UL E142422
- High Thermal Radiation

**外形寸法図 OUTLINE DIMENSIONS**



(製品上の表示については、捺印仕様をご確認ください)

**定格表 RATINGS**

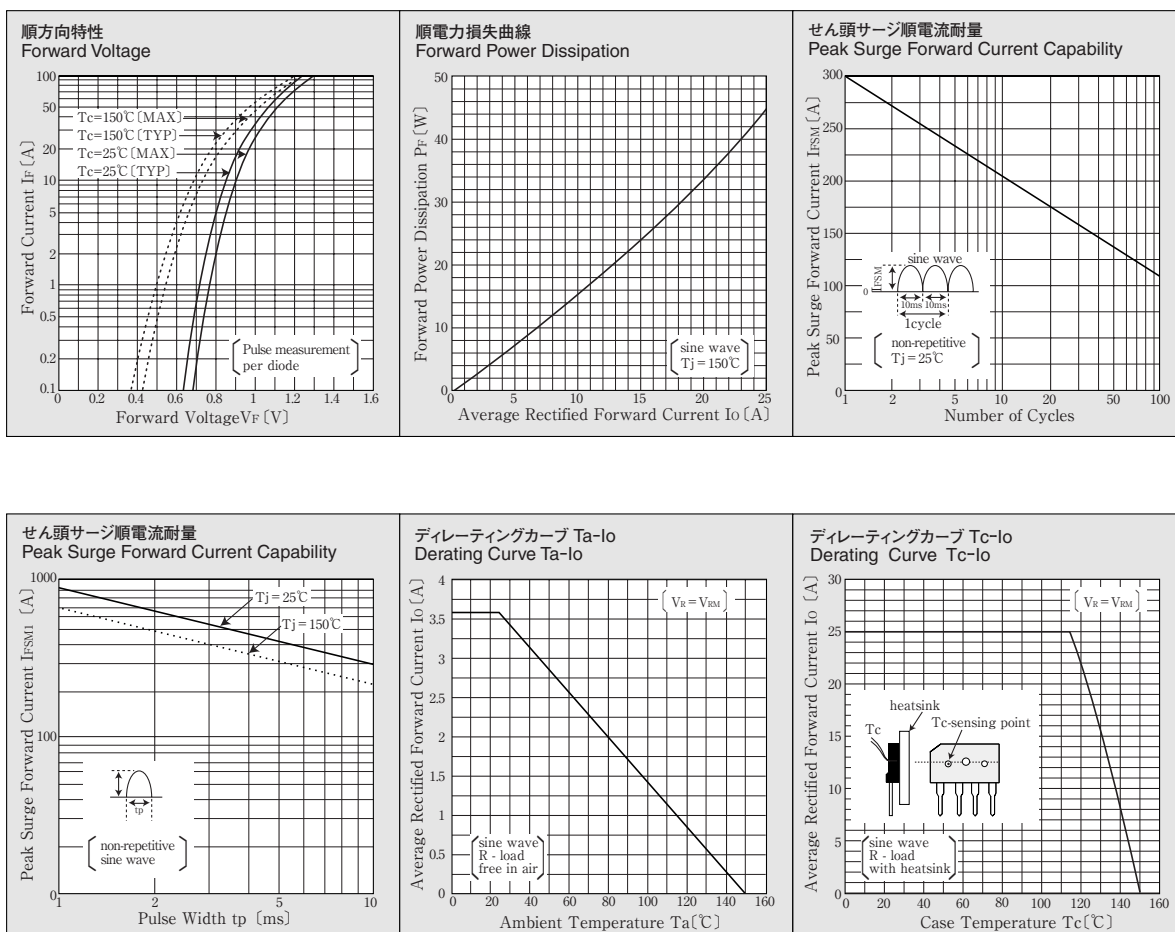
●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合は  $T_c = 25^\circ\text{C}$  / unless otherwise specified)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	LL25XB60	単位 Unit	
保存温度 Storage Temperature	Tstg			-55~150	°C	
接合部温度 Operation Junction Temperature	Tj			150	°C	
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V <sub>RM</sub>			600	V	
出力電流 Average Rectified Forward Current	I <sub>O</sub>	50Hz 正弦波, 抵抗負荷 50Hz sine wave, Resistance load	フィン付き With heatsink	T <sub>c</sub> =113°C	25	A
			フィンなし Without heatsink	T <sub>a</sub> =25°C	3.6	
せん頭サーージ順電流 Peak Surge Forward Current	I <sub>FSM</sub>	50Hz 正弦波, 非繰り返し1サイクルせん頭値, T <sub>j</sub> =25°C 50Hz sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, T <sub>j</sub> =25°C		300	A	
	I <sub>FSM1</sub>	tp=1ms 正弦波, 非繰り返し1サイクルせん頭値, T <sub>j</sub> =25°C tp=1ms sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, T <sub>j</sub> =25°C		945		
電流二乗時間積 Current Squared Time	I <sup>2</sup> t	1ms ≤ t < 10ms T <sub>j</sub> =25°C	一素子当たりの規格値 per diode	450	A <sup>2</sup> s	
絶縁耐圧 Dielectric Strength	V <sub>dis</sub>	一括端子・ケース間, AC 1分間印加 Terminals to Case, AC 1 minute		2.5	kV	
締め付けトルク Mounting Torque	TOR	(推奨値: 0.5 N・m) (Recommended torque : 0.5 N・m)		0.8	N・m	

●電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合は  $T_c = 25^\circ\text{C}$  / unless otherwise specified)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	規格値 Specified Value	単位 Unit
順電圧 Forward Voltage	V <sub>F</sub>	I <sub>F</sub> =12.5A, パルス測定, 一素子当たりの規格値 Pulse measurement, per diode	TYP 0.87 MAX 0.92	V
逆電流 Reverse Current	I <sub>R</sub>	V <sub>R</sub> =600V, パルス測定, 一素子当たりの規格値 Pulse measurement, per diode	MAX 10	μA
逆回復時間 Reverse Recovery Time	trr	I <sub>F</sub> =0.1A, I <sub>R</sub> =0.1A, 一素子当たりの規格値 per diode	MAX 3.0	μs
熱抵抗 Thermal Resistance	θ <sub>jc</sub>	接合部・ケース間, フィン付き Junction to Case, With heatsink	MAX 0.8	°C/W
	θ <sub>jl</sub>	接合部・リード間, フィンなし Junction to Lead, Without heatsink	MAX 5.0	
	θ <sub>ja</sub>	接合部・周囲間, フィンなし Junction to Ambient, Without heatsink	MAX 25	

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



- ・ Sine waveは50Hzで測定しています。
- ・ 50Hz sine wave is used for measurements.
- ・ 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っており、Typicalは統計的な実力を表しています。
- ・ Semiconductor products generally have characteristic variation. Typical is a statistical average of the device's ability.